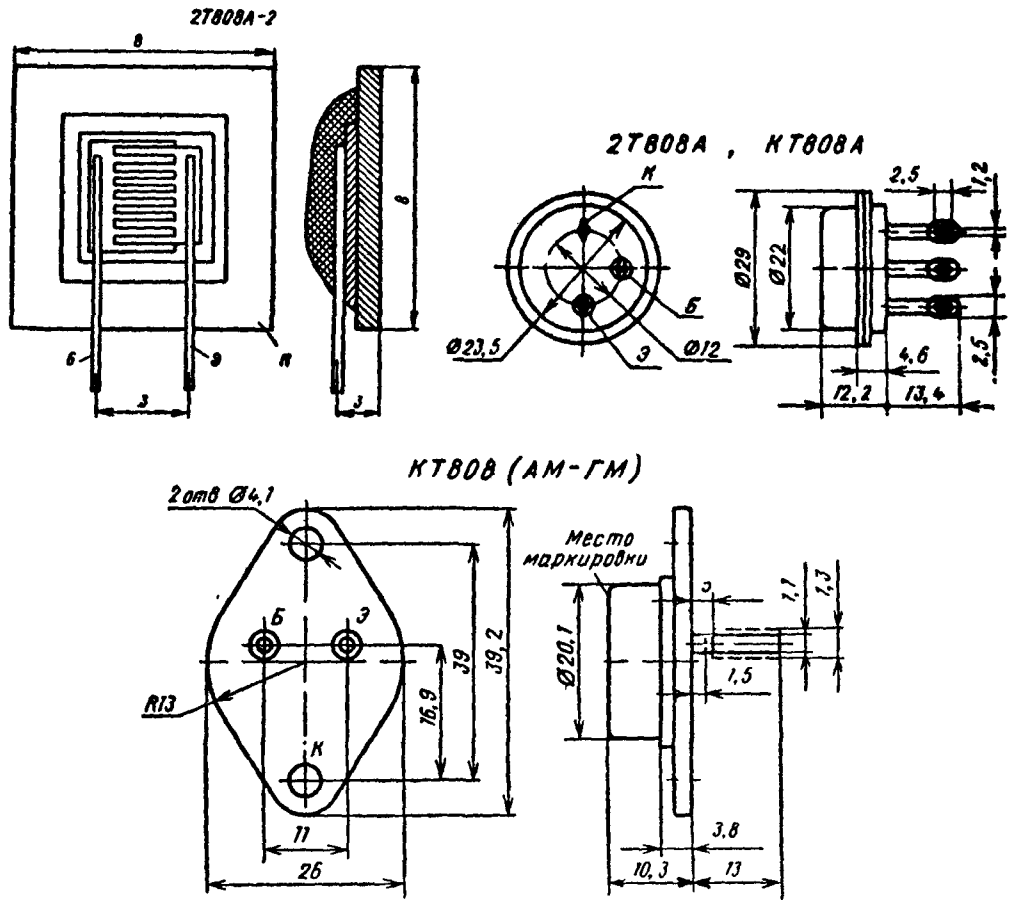


# 2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808 (АМ, БМ, ВМ, ГМ)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *p-n-p* переключабельные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Корпус транзисторов 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ — КТ808ГМ металлический со стеклянными выводами и жесткими выводами. Транзистор 2Т808А-2 — бескорпусный на металлической молибденовой подложке с защитным покрытием и гибкими выводами.

Масса транзисторов 2Т808А, КТ808А (без накидного фланца) не более 22 г, КТ808АМ — КТ808ГМ — не более 20 г, 2Т808А-2 — не более 0,6 г.



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А при $U_{кэ}=3$ В, $I_k=6$ А:	
$T=+25^\circ\text{C}$	10...15*...50
$T=+125^\circ\text{C}$ 2Т808А и $T=+100^\circ\text{C}$ КТ808А	10...20*...150
$T=-60^\circ\text{C}$	6...10*...50
КТ808АМ—КТ808ГМ при $U_{кэ}=3$ В, $I_k=2$ А	20...125
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ}=10$ В, $I_b=0,5$ А, $f=3,5$ МГц, не менее	
	2,4
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер КТ808АМ—КТ808ГМ при $I_k=6$ А, $I_b=0,6$ А, не более	
	2 В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k=6$ А, $I_b=0,6$ А	
	1*...1,4*...2,5 В
Время рассасывания при $U_{кэ}=15$ В, $I_k=6$ А, не более	
	2 мкс
Обратный ток коллектор — эмиттер при $R_{сэ}=10$ Ом, не более:	
$T=+25$ и $-60^\circ\text{C}$ и $U_{кэ}=200$ В 2Т808А, 2Т808А-2 и $U_{кэ}=120$ В КТ808А	3 мА
$T=+125^\circ\text{C}$ , $U_{кэ}=160$ В 2Т808А, 2Т808А-2	20 мА
$T=+100^\circ\text{C}$ , $U_{кэ}=120$ В КТ808А	50 мА
Обратный ток коллектора КТ808АМ—КТ808ГМ при $U_{кэ}=U_{кэ, макс}$ , $T=+25^\circ\text{C}$ , не более	
	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ}=4$ В, не более	
	50 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кэ}=10$ В, $f=1$ МГц, не более	
	500 пФ

## Предельные эксплуатационные данные.

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер <sup>1</sup> при $R_{сэ}=10$ Ом, $T_n \leq 100^\circ\text{C}$ :	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	120 В
КТ808АМ	130 В
КТ808БМ	100 В
КТ808ВМ	80 В
КТ808ГМ	70 В
Импульсное напряжение коллектор — эмиттер <sup>1</sup> при $U_{бэ}=2$ В или $R_{сэ}=10$ Ом, $t_u \leq 500$ мкс, $t_\phi \geq 30$ мкс, $Q \geq 7$ , $T_n \leq +100^\circ\text{C}$	
	250 В
Постоянное напряжение эмиттер — база:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	4 В
КТ808АМ—КТ808ГМ	5 В
Постоянный ток коллектора	
	10 А
Постоянный ток базы	
	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_n = -60...+50^\circ\text{C}$ :	
с теплоотводом:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	50 Вт
КТ808АМ—КТ808ГМ	60 Вт
без теплоотвода 2Т808А, КТ808А	
	5 Вт
Тепловое сопротивление переход — корпус	
	$2^\circ\text{C}/\text{Вт}$
Температура <i>p-n</i> перехода	
	$+150^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды:	
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808АМ—КТ808ГМ	$-60^\circ\text{C}...T_n=+125^\circ\text{C}$
КТ808А	$-60^\circ\text{C}...T_n=+100^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_n = +100...+150^\circ\text{C}$  постоянное и импульсное напряжения коллектор — эмиттер снижаются линейно на 10% на каждые  $10^\circ\text{C}$ . Температура перехода рассчитывается по формуле

$$T_n = T_n + R_{T(n-k)}(P_k + P_b)$$

Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора (от места выхода вывода из компаунда), температура пайки 2Т808А-2 не более  $+250^\circ\text{C}$ , 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ — КТ808ГМ не более  $+275^\circ\text{C}$  в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2Т808А-2 составляет 300 В.